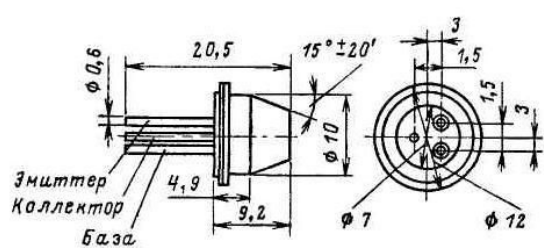


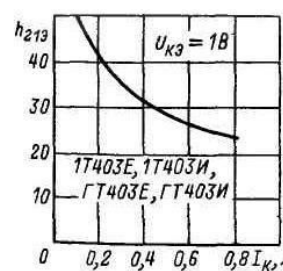
**1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д,
1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б,
ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж,
ГТ403И, ГТ403Ю**

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р усилительные низкочастотные маломощные.
Предназначены для работы в схемах переключения, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе
Масса транзистора не более 4 г.



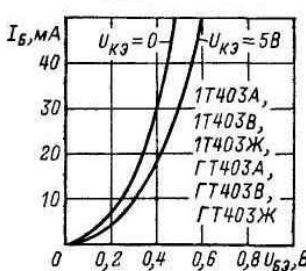
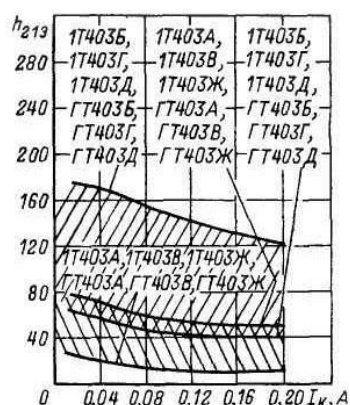
Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,05 \text{ А}$ не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,05 \text{ А}$ не более	0,8 В
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 0,1 \text{ А}$, $f = 50 \div 300 \text{ Гц}$:	
1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж	20–60
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д	50–150
ГТ403Ю	30–60
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1 \text{ В}$, $I_3 = 0,45 \text{ А}$ 1Т403Е, ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И не менее	30
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 0,1 \text{ А}$, $f = 50 \div 300 \text{ Гц}$ не более:	
при $T = 343 \text{ К}$	$\pm 30 \%$
при $T = 213 \text{ К}$	-50%

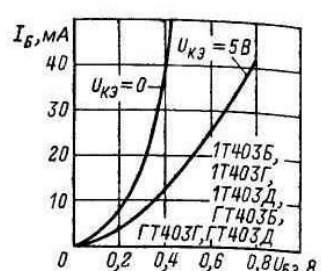


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Зона возможных положений зависимости статического коэффициента тока от тока коллектора.



Входные характеристики



Входные характеристики

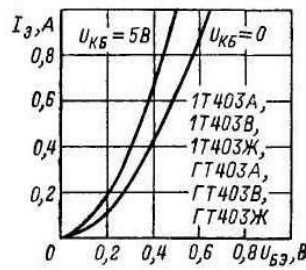
Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 1Т403Е, 1Т403И при $U_{КБ} = 1 \text{ В}$, $I_3 = 0,45 \text{ А}$ не более	
при $T = 343 \text{ К}$	$\pm 30 \%$
при $T = 213 \text{ К}$	$+50 \%$ -40%

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 0,1 \text{ А}$ не менее	8 кГц
Плавающее напряжение эмиттер-база при $U_{КБ} = 45 \text{ В}$ 1Т403А, 1Т403Б, при $U_{КБ} = 60 \text{ В}$ 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, при $U_{КБ} = 80 \text{ В}$ 1Т403Ж, 1Т403И при $T = 343 \text{ К}$ не более	0,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ \text{ макс}}$ не более при $T = 298 \text{ К}$	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343 \text{ К}$	800 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 20 \text{ В}$ 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю, $U_{БЭ} = 30 \text{ В}$ 1Т403Д, ГТ403Д не более при $T = 298 \text{ К}$	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343 \text{ К}$	800 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$ 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	5 мА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	6 мА

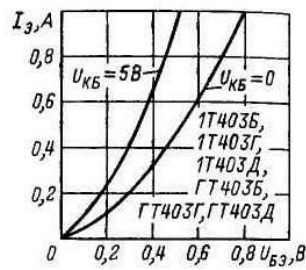
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	30 В
1Т403В, 1Т403Г, ГТ403В, ГТ403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403Д, ГТ403Е	45 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база 1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю	45 В
1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д	60 В
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	80 В
Постоянное напряжение эмиттер-база 1Т403Д, ГТ403Д	20 В 30 В
Постоянный ток коллектора	1,25 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом	$(358 - T_K) / R_{Т \text{ п-к}}$ Вт
без теплоотвода	$(358 - T) / R_{Т \text{ п-с}}$ Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус 1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е	15 К/Вт 12 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	100 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды 1Т403	От 213 до 343 К
ГТ403	От 218 до 343 К

Примечание Разрешается производить изгиб и пайку выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с температурой жала паяльника не более 533 К в течение 3 с и групповым или механизированным способом при температуре припоя не более 533 К в течение 5 с



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер